

**Перечень тем для написания эссе по направлению «11.04.04 Нейроморфная электроника систем искусственного интеллекта»**

1. Материалы и технологии создания структур элементов резистивной оперативной памяти.
2. Нейроморфные структуры: материалы, методы изготовления, применение.
3. Мемристорные структуры на основе оксида.
4. Методы нанолитографии и перспективы применения зондовых нанотехнологий при формировании структур элементов наноэлектроники.
5. Физические принципы работы мемристорных структур.